

静电场

第一节 库仑定律 电场强度

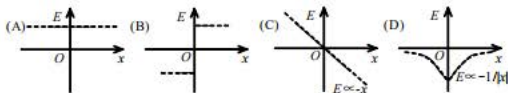
1. 关于电场强度定义式 $\vec{E} = \vec{F}/q_0$, 下列说法正确的是 [B]

- A 电场强度 \vec{E} 的大小与试验电荷 q_0 的大小成反比; \times
 B 在电场中某一点, 试验电荷受力 \vec{F} 与 q_0 的比值不因 q_0 而变; \checkmark
 C 试验电荷受力 \vec{F} 的方向就是电场强度 \vec{E} 的方向; \checkmark
 D 若电场中某点不存在试探电荷 q_0 , 则 $\vec{F} = 0$, 从而 $\vec{E} = 0$; \times

2. 在边长为 a 的正立方体中心处放置一电量为 Q 的点电荷, 则正立方体顶角处的电场强度的大小为: [C]

A $\frac{Q}{12\pi\epsilon_0 a^2}$; B $\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 a^2}$; C $\frac{Q}{3\pi\epsilon_0 a^2}$; D $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

3. 设有一“无限大”均匀带正电荷的平面, 取 x 轴垂直带电平面, 坐标原点位于带电平面上, 则其周围空间各点的电场强度 E 随距离平面的位置坐标 x 变化的关系曲线为(规定场强方向沿 x 轴正向为正、反之为负): [B]



4. 两个平行的无限大均匀带电平面, 其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 -2σ , 如图所示, 则 A、B、C 三个区域的电场强度分别为:

$$E_A = \frac{+\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E_B = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E_C = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \quad (\text{设方向向右为正}).$$



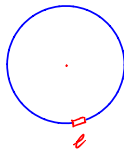
5. 将一根电荷线密度为 λ 的均匀带电绝缘细线围成边长为 l 的正方形线框, 则在正方形中心处的电场强度大小 $E = 0$.

6. 一个电荷线密度为 λ 的均匀带正电圆环, 如果在圆环上截掉长度为 l 的一段 ($l \ll$ 圆环半径 R), 求圆心处电场强度的大小和方向.

将 l 段用电荷密度为 $+\lambda, -\lambda$ 同时补齐。
 均匀带电圆环在圆心产生的电场为 0。

$$\Delta q = -\lambda l$$

$$E = -\frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 R^2} \vec{e}_r$$



7. 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形, 沿其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$, 沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$, 如图所示. 试求圆心 O 处的电场强度的大小和方向.

解: 选取上下对称一段元电荷,

$$dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$$

$$\vec{dE}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d\theta}{R^2} \vec{e}_+$$

$$dE_{+x} = |\vec{E}_+| \sin\theta$$

$$dE_{+y} = -|\vec{E}_+| \cos\theta$$

$$dE_{-x} = -|\vec{E}_-| \sin\theta$$

$$dE_{-y} = -|\vec{E}_-| \cos\theta$$

$$dE_x = 0$$

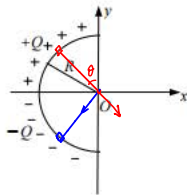
$$dE_y = -2|\vec{E}| \cos\theta = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d\theta}{R^2} \cos\theta$$

$$E_y = \int_0^{\pi} dE_y = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \int_0^{\pi} \cos\theta d\theta$$

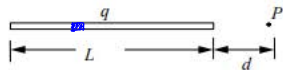
$$= -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R}$$

$$\text{因 } \lambda = \frac{Q}{\frac{1}{2}\pi R}$$

$$\text{代入 } E_y = -\frac{Q}{\pi^2 \epsilon_0 R^2}$$



8. 如图所示, 真空中一长为 L 的均匀带电细直杆, 总电量为 q , 试求在直杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点处的电场强度.



解:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(L+d-x)^2}$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{(L+d-x)^2}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left. \frac{1}{L+d-x} \right|_{x=0}^{x=L}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{L+d} \right)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{L}{d(L+d)}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d(L+d)}$$

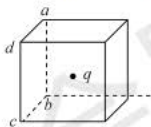
第二节 电通量 高斯定律

1. 根据高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ 可知下述各种说法中, 正确的是: [C]

- A 闭合面内电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强一定为零. ~~X~~
 B 闭合面内电荷代数和不为零时, 闭合面上各点场强一定处处不为零. ~~X~~
 C 闭合面内电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强不一定处处为零.
 D 闭合面上各点场强均为零时, 闭合面内一定处处无电荷. ~~X~~

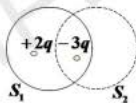
2. 如图所示, 一个电量为 q 的点电荷位于立方体的中心, 则通过侧面 $abcd$ 的电通量等于: [A]

- A $\frac{q}{6\epsilon_0}$. B $\frac{q}{12\epsilon_0}$.
 C $\frac{q}{24\epsilon_0}$. D $\frac{q}{48\epsilon_0}$.



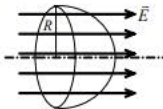
3. 如图所示, 两个高斯面的电通量正确的是 [B]

- A $\Phi_{S_1} = \frac{2q}{\epsilon_0}$. ~~X~~
 B $\Phi_{S_1} = \frac{-q}{\epsilon_0}$.
 C $\Phi_{S_2} = \frac{q}{\epsilon_0}$. ~~X~~
 D $\Phi_{S_2} = 0$. ~~X~~



4. 半径为 R 的半球置于场强为 \vec{E} 的均匀电场中, 其对称轴与场强方向一致, 如图所示. 则通过该半球面的电场强度通量为

$$E\pi R^2$$

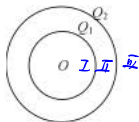


5. 如图所示, 两个同心的均匀带电球面, 内球面半径 R_1 带电荷 Q_1 , 外球面半径 R_2 带电荷 Q_2 , 使用高斯定理求空间各处场强的大小

$$\text{I: } E = 0 \quad r < R_1$$

$$\text{II: } E = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad R_1 < r < R_2$$

$$\text{III: } E = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r > R_2$$



6. 两个“无限长”内外半径分别为 R_1 和 R_2 的共轴圆柱面, 均匀带电, 沿轴线方向单位长度带电荷分别为 λ_1 和 λ_2 , 则在外圆柱面外面、距离轴线为 r 处的电场强度大小 E 为多少?

根据电场强度的高斯定理.

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2) h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$$

7. 一非均匀带电球体电荷密度的分布可以表示为:

$$\rho(r) = \rho_0(1-r/R) \quad r \leq R \quad \rho_0 = 3Q/\pi R^3 \quad \rho(r) = 0 \quad r > R, \text{ 求电场强度}$$

随 R 的变化关系, 在什么位置电场强度有极大值?

取半径为 r 的球面.

$$E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$Q = \int \rho(r) dV = 4\pi \int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) r^2 dr$$

$$= 4\pi \rho_0 \left(\frac{1}{3} r^3 - \frac{1}{4} \frac{r^4}{R} \right)$$

$$E_{(r)} = \frac{4\pi \rho_0 \left(\frac{1}{3} r^3 - \frac{1}{4} \frac{r^4}{R} \right)}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{3} r - \frac{1}{4} \frac{r^2}{R} \right)$$

对 r 求导

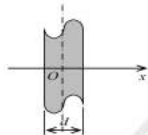
$$E_{(r)} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{\frac{1}{3}\pi R^3 \rho_0}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$\frac{dE(r)}{dr} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \frac{r}{R} \right) = 0$$

$r = \frac{2}{3} R$ 时电场强度有极值.

因 $\frac{d^2 E(r)}{dr^2} = -\frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{1}{2R} < 0$ 所以 E 有极大值

8. 图示一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板, 电荷密度为 ρ . 试求板内外的场强分布, 并画出场强随坐标 x 变化的图线, 即 $E-x$ 图线(设原点在带电平板的中央平面上, Ox 轴垂直于平板).



平板以外

$$E = \frac{\rho \cdot d}{2\epsilon_0}$$

取平板的横截面.

$$E \cdot 2s = \frac{\rho s \cdot 2\pi}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\rho x}{\epsilon_0}$$

9. 思考题

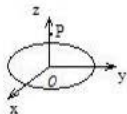
如果在一个曲面上每点的场强均为零, 那么穿过此曲面的电场强度通量也为零吗? 如果穿过曲面的电场强度通量为零, 那么, 能否说此曲面上每一点的场强也必为零呢?

是, 否

第三节 电势 电势能

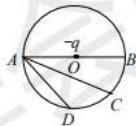
1. 有 N 个电量均为 q 的点电荷, 以两种方式分布在相同半径的圆周上: 一种是无规则地分布, 另一种是均匀分布. 比较这两种情况下, 过圆心 O 并垂直于圆平面的 z 轴上任一点 P (如图所示) 的场强与电势, 则有 [C]

- A 场强相等, 电势相等.
 B 场强不等, 电势不等.
 C 场强分量 E_z 相等, 电势相等.
 D 场强分量 E_z 相等, 电势不等.



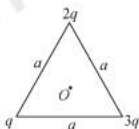
2. 点电荷 $-q$ 位于圆心 O 处, A 、 B 、 C 、 D 为同一圆周上的四点, 如图所示. 现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B 、 C 、 D 各点, 则 [D]

- A 从 A 到 B , 电场力做功最大.
 B 从 A 到 C , 电场力做功最大.
 C 从 A 到 D , 电场力做功最大.
 D 从 A 到各点, 电场力做功相等.



3. 如图所示, 一等边三角形边长为 a , 三个顶点上分别放置着电量为 q 、 $2q$ 、 $3q$ 的正点电荷, 设无穷远处为电势零点, 则三角形中心 O 处的电势 $V =$

$$\frac{3\sqrt{3}q}{2\pi\epsilon_0 a}$$



4. 把一个均匀带有电荷 $+Q$ 的球形肥皂泡由半径 r_1 吹胀到 r_2 , 则半径为 R ($r_1 < R < r_2$) 的球面上任一点的场强大小 E 由 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ 变为 0 ; 电势 V 由 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 变为 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$ (选无穷远处为电势零点).

5. 如图所示, 虚线表示等势面, 则 $E_A > E_B$, (填写 “>” “<” 或 “=”) 如果 A 点有带正电的电荷点运动到 B 电场力做正功, 则 $V_A > V_B$ (填写 “>” “<” 或 “=”)

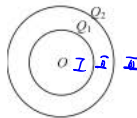


6. 如图所示, 两个同心的均匀带电球面, 内球面半径 R_1 带电荷 Q_1 , 外球面半径 R_2 带电荷 Q_2 , 求空间各处的电势 (设无穷远为电势零点).

$$V_{I} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{R_2} \right) \quad r < R_1$$

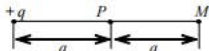
$$V_{II} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} \right) \quad R_1 < r < R_2$$

$$V_{III} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad r > R_2$$

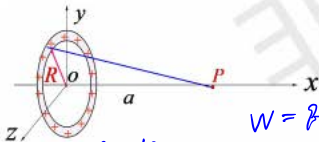


7. 在点电荷 $+q$ 的电场中, 若取图中 P 点处为电势零点, 求 M 点电势。

$$\begin{aligned} V_M &= \int_{2a}^a \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{2a}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{a} - \left(-\frac{1}{2a}\right) \right) \\ &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2a} \\ &= -\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a} \end{aligned}$$



8. 图示为一个均匀带电的圆环, 其电荷线密度为 λ , 半径为 R , 设无穷远处为电势零点, 求(1)圆环中轴线上距离 O 点为 a 处的电势 V_a 。(2)一个电量为 q 的点电荷沿着中轴线从距离 O 点为 a 处运动到距离 O 点为 b 的地方, 求电场力所做的功 W



$$\begin{aligned} V_a &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \\ &= \frac{\lambda \cdot 2\pi R}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + R^2}} \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{a^2 + R^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= q(V_a - V_b) \\ &= q \frac{2R}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2 + R^2}} \right) \end{aligned}$$

9. 思考题

电荷 q 从电场的A点移到B点, 若使B点的电势比A点的电势低, 而B点的电势能又比A点的电势能要大, 这可能吗? 为什么?

可能, $q < 0$

静电场中的导体与电介质

第一节 静电场中的导体 (1)

1. 一球形导体球内有一球形空腔, 两者的球心不重合, 如图所示, 如果将某正电荷置于空腔的球心处, 则导体球表面的感应电荷密度:

[D]

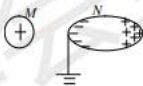
- A 内、外球面上都不均匀
B 在内球面上是均匀的, 外球面上不均匀
C 在内球面上不均匀的, 外球面上是均匀
D 内、外球面上都均匀



2. 一带正电荷的物体 M , 靠近一原不带电的金属导体 N , N 的左端感生出负电荷, 右端感生出正电荷. 若将 N 的左端接地, 如图所示, 则 N 上的电荷如何变化?

[B]

- A N 上的负感应电荷被大地电荷中和;
B N 上有正感应电荷被大地电荷中和;
C N 上的感应电荷分布不变;
D N 上不再有感应电荷.



3 任意带电体在导体体内(不是空腔导体的腔内) 会 (填: 会或不会)产生电场, 处于静电平衡下的导体, 空间所有电荷(含感应电荷)在导体体内产生电场的 矢量 (填: 矢量和标量)叠加为零.

4. 处于静电平衡下的导体 是 (填: 是或不是)等势

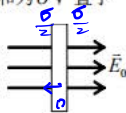
体, 导体表面 是 (填: 是或不是)等势面, 导体表面附近的电场线与导体表面相互 垂直, 导体体内的电势 等于 (填: 大于, 等于或小于) 导体表面的电势.

5. 一点电荷电量为 $-2.0\mu\text{C}$ 位于导体球壳的球心处, 球壳内外半径分别是 4 和 6cm, 球壳外是均匀带电的绝缘体, 所带电荷密度为 $3.75 \times 10^{-4}\text{C}/\text{m}^3$, 则距离点电荷 9cm 处的电场强度是 $1.33 \times 10^{-6}\text{N/C}$

$$p. \frac{q \pi (0.06^3 - 0.04^3) - 2 \times 10^{-6} \text{C}}{4\pi \epsilon_0 (0.09)^2}$$

6. 电量为 $-Q$ 的点电荷置于一金属空腔(电中性)内, 则空腔外表面的净电荷总量是 $-Q$, 如果空腔外侧与地面通过导线连接, 则空腔表面的净电荷总量是 Q .

7. 一带电大导体平板, 板的两表面电荷面密度之和为 σ , 置于电场强度为 E_0 的均匀电场中, 平板法线与外场平行, 设外电场分布不因导体的引入而改变, 则板附近左右两侧的合场强分别为 $E_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, $E_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.



8. 两个同心球壳, 小球壳的内外径分别为 a 、 b , 大球壳的内外径为 c 、 d , 小球壳带电 $+2Q$, 大球壳带电 $+4Q$ 。求下列区域的电场强度。

1) $a < r < b$, 2) $c < r < d$, 3) $r > d$

$$(1) E = 0.$$

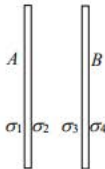
$$(2) 0$$

$$(3) \vec{E} = \frac{6Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

9. 如图所示, 面积均为 $S=0.1\text{m}^2$ 的两金属平板 A, B 平行对称放置, 间距为 $d=1\text{mm}$, 今给 A, B 两板分别带电 $Q_1=3.54 \times 10^{-7}\text{C}$, $Q_2=1.77 \times 10^{-7}\text{C}$ 。忽略边缘效应,

求: (1) 两板共四个表面的面电荷密度 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$;

(2) 两板间的电势差 $V=U_A-U_B$ 。



解: 对于个无限大的带电板, 每个带电板两侧的电场 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 。

因为静电平衡时, 导体内 $E=0$ 。

所以A导体的电场

$$\begin{cases} E_A = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \\ E_B = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \quad (1) \\ \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$$\text{结合} \begin{cases} \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q_1}{S} \quad (3) \\ \sigma_3 + \sigma_4 = \frac{Q_2}{S} \quad (4) \end{cases}$$

$$\sigma_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{Q_1}{S} + \frac{Q_2}{S} \right) = 2.655 \times 10^{-8} \text{C/m}^2$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{Q_1}{S} - \frac{Q_2}{S} \right) = 8.85 \times 10^{-9} \text{C/m}^2$$

$$\sigma_3 = -\sigma_2 = -8.85 \times 10^{-9} \text{C/m}^2, \quad \sigma_4 = \sigma_1 = 2.655 \times 10^{-8} \text{C/m}^2$$

10. 思考题 将一个带电小金属与一个不带电的大金属球相接触, 小球上的电荷会全部转移到地球上吗?

不会。

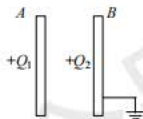
第一节 静电场中的导体 (2)

1. 在导体的某个区域分布有密度 σ 的负电荷, 那么在该区域靠近导体的一侧, 电力线的方向为: [B]

- A 指向导体的外表面。
B 指向导体的内表面。
C 为零。
D 与导体表面平行。

2. A 、 B 为两导体大平板, 面积均为 S , 平行放置, 如图所示. A 板带电荷 $+Q_1$, B 板带电荷 $+Q_2$, 如果使 B 板接地, 则 AB 间电场强度的大小 E 为: [C]

- A. $\frac{Q_1}{2\epsilon_0 S}$ B. $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$
C. $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$ D. $\frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$



3. 一无限大均匀带电平面 A , 所带电荷面密度为 σ , 在附近放入一厚度为 d 的无限大导体, 两导体面平行, 则导体 B 上的两个面上的感生电荷面密度分别为: [B]



- A $\sigma_1 = -\sigma$ $\sigma_2 = +\sigma$ B $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$ $\sigma_2 = \frac{1}{2}\sigma$
C $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$ $\sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$ D $\sigma_1 = -\sigma$ $\sigma_2 = 0$

4. 在一个孤立的导体球壳内在偏离球心处放入一点电荷, 则在球壳内外将出现感应电荷, 其分布将是: [B]

- A、内表面均匀, 外表面也均匀。
B、内表面不均匀, 外表面均匀。
C、内表面均匀, 外表面不均匀。
D、内表面不均匀, 外表面不均匀。

5. 一椭圆形金属导体的两点 a 、 b 的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 , 则 a 点附近的导体内外的电场强度分别是: $E_{内} = 0, E_{外} = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0}$ 若 $\sigma_1 > \sigma_2$, 则曲率较大的点是 a 点。

6. 两个同心薄导体球壳, 半径分别是 R_1 、 R_2 ($R_1 < R_2$), 分别带有电量 q_1 和 q_2 , 现用导线将两球连接, 则连接后的导体球的电势为 $\frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$ 。(以无限远处为势能零点)。

7. 一厚度为 d 的无限大导体平板, 电荷面密度为 σ , 则板的两侧距板平面为 h 的两点 a 和 b 的电势差为 0。

$$V = 2E \cdot h$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

8. 一孤立金属球, 带有电荷 $1.2 \times 10^{-8} \text{ C}$, 已知当电场强度的大小为 $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ 时, 空气将被击穿. 若要空气不被击穿, 则金属球的半径至少大于多少?

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} < E_0$$

$$R^2 > \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 E_0}$$

$$R > \sqrt{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 E_0}}$$

9. 如图, 把一块原来不带电的金属板 B , 移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A , 平行放置. 设两板面积都是 S , 板间距离是 d , 忽略边缘效应. 当 B 板不接地时, 两板间电势差 $U_{AB} = ?$ B 板接地时两板间电势差 $U'_{AB} = ?$

$$\sigma_1 = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_2 = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

$$E = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$$

$$U_{AB} = E \cdot d = \frac{Qd}{2\epsilon_0 S}$$

当 B 板接地

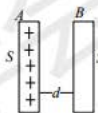
$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

$$\sigma_3 = -\frac{Q}{S}$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

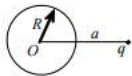
$$U'_{AB} = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}$$



10. 真空中一半径为 R 的未带电的导体球, 在离球心 O 的距离为 a 处 ($a > R$) 放一点电荷 q , 如图所示. 设无穷远处电势为零, 则导体球的电势等于多少?

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{\int \sigma dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$$



11. 如图所示, 一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电, 其电荷线密度为 λ . 在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒, 圆筒原先不带电, 但与地连接. 设地的电势为零, 则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分布为多少?

$$E \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$V = \int_r^b E \cdot dr$$

$$= \int_r^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

